

Pojemność elektryczna

Równanie kondensatora:

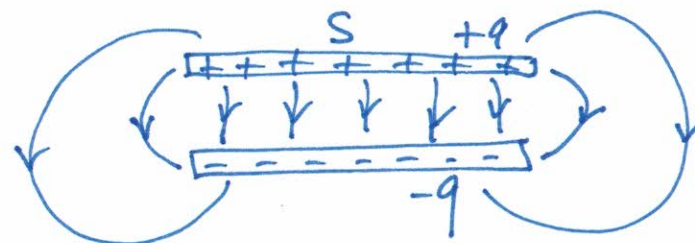
$$q = CU$$

$U = \Delta V$
napiecie

C - pojemność kondensatora

Jednostka pojemności w układzie SI

$$1 \text{ farad} = 1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}} \left(\frac{\text{Kulomb}}{\text{wolt}} \right)$$



Kondensator płaski:

Natężenie pola elektrycznego w kondensatorze

Prawo Gaussa: $\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q$

$$\Rightarrow \epsilon_0 ES = q$$

$$\underline{E = \frac{q}{\epsilon_0 S}}$$

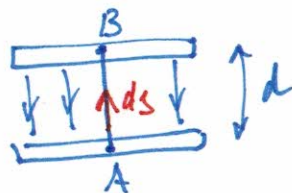


Napiecie na kondensatorze

$$U = \int_A^B E ds = Ed$$

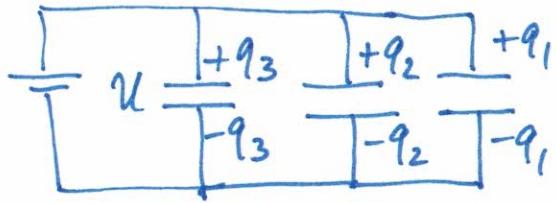
$$C = \frac{U}{q} = \frac{Ed}{\epsilon_0 ES}$$

$$\boxed{C = \frac{\epsilon_0 S}{d}}$$



Kondensator płaski:

Kondensatory połączone równolegle



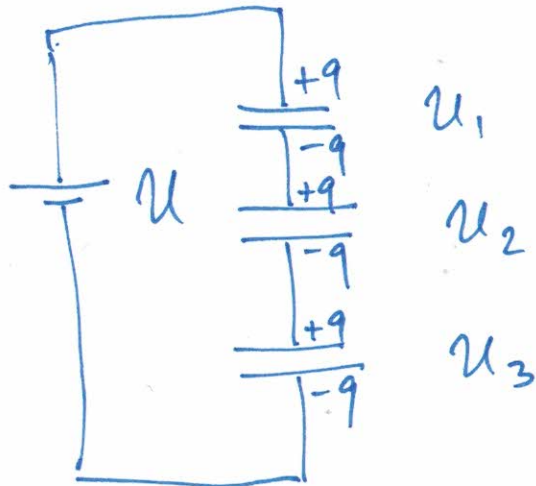
$$q_1 = C_1 U, \quad q_2 = C_2 U, \quad q_3 = C_3 U$$

$$q = q_1 + q_2 + q_3 = (C_1 + C_2 + C_3) U$$

$$C_{zw} = \sum_{j=1}^n C_j$$

n kondensatorów

Kondensatory połączone szeregowo



$$U_1 = \frac{q}{C_1}, \quad U_2 = \frac{q}{C_2}, \quad U_3 = \frac{q}{C_3}$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)$$

$$\frac{1}{C_{zw}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{C_j}$$

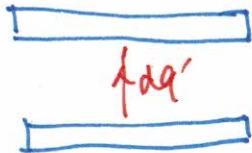
Energia zgmagazynowana w polu elektrycznym

3.

Praca przeniesienia ładunku dq' z jednej płytki kondensatora na drugą:

$$dW = U' dq' = \frac{q'}{C} dq'$$

$$W = \int dW = \frac{1}{C} \int_0^q q' dq' = \frac{q^2}{2C}$$



$$E_p = \frac{q^2}{2C}$$

$$E_p = \frac{1}{2} C U^2$$

$\Delta V = -\frac{W}{q}$
 U' - napięcie w chwili, kiedy przeniesiony ładunek stanowił q'

q - całkowity ładunek przeniesiony z jednej płytki na drugą

Gęstość energii pola elektrycznego

$$u = \frac{E_p}{Sd} = \frac{CU^2}{2Sd} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{U}{d}\right)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

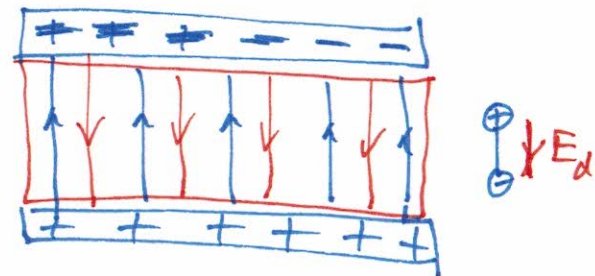
$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$E = \frac{U}{d}$$

Kondensator z dielektrykiem

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d} = \epsilon_r C_{\text{próżni}}$$

ϵ_r - przenikalność elektryczna
względna materiału izolującego
(dielektryka)



W obszarze wypełnionym całkowicie materiałem dielektrycznym o względnej przenikalności ϵ_r wszystkie równania elektrostatyki, zawierające przenikalność elektryczną próżni ϵ_0 należy zmodyfikować, zastępując ϵ_0 przez $\epsilon_r \epsilon_0$

Przenikalność dielektryków ϵ_r

Powietrze	1,00054
Porcelana	6,5
tytanian strontu	310

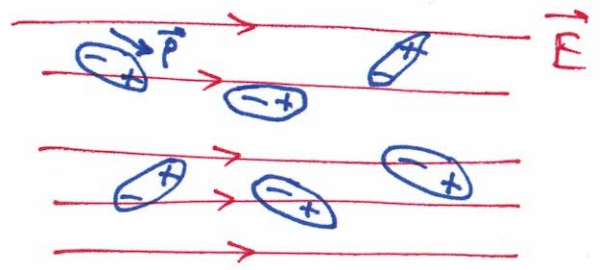
Pole elektryczne ładunku punktowego wewnątrz dielektryka:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Dielektryki: obraz mikroskopowy

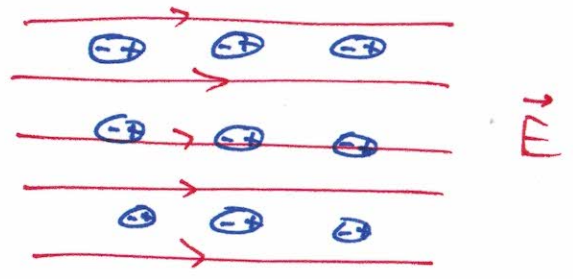
1) Dielektryki polarne: cząsteczki mają trwałe momenty dipolowe (np. woda)

Uporzędkowane dipole elektryczne wytwarzają pole elektryczne skierowane przeciwnie do przyłożonego pola i mniejszej wartości

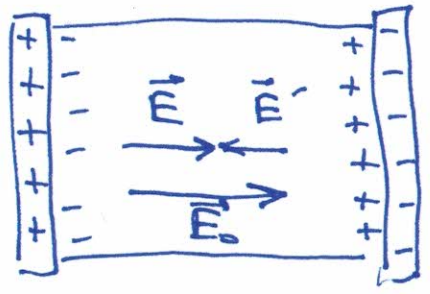


2) Dielektryki niepolarne: po umieszczeniu w zewnętrznym polu elektrycznym cząsteczek uzyskują indukowane momenty dipolowe

Bez pola moment dipolowy $\vec{P} = 0$



Kondensator z dielektrykiem:



$E < E_0$

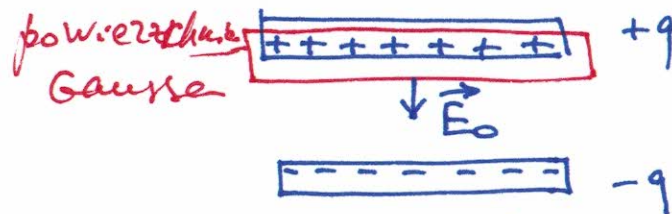
\vec{E}_0 - przyłożone pole
 \vec{E}' - pole ładunków powierzchniowych
 \vec{E} - pole wypadkowe

Dielektryki i prawo Gaussa

Bez dielektryka:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \epsilon_0 E_0 S = q$$

$$E_0 = \frac{q}{\epsilon_0 S}$$

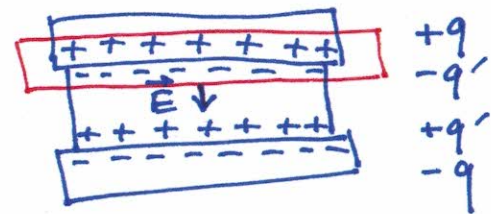


Kondensator bez dielektryka

Z dielektrykiem:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \epsilon_0 E S = q - q'$$

$$E = \frac{q - q'}{\epsilon_0 S}$$



Kondensator z dielektrykiem

Wprowadzimy ϵ_r przez wyrażenie

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r} = \frac{q}{\epsilon_r \epsilon_0 S}$$

$$\Rightarrow q - q' = \frac{q}{\epsilon_r}$$

Prawo Gaussa dla dielektryka:

$$\boxed{\epsilon_0 \oint \epsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{S} = q}$$

całke strumienia zawiera $\epsilon_r \vec{E}$, a nie \vec{E}

Wektor $\epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$ nazywamy indukcją elektryczną \vec{D} .

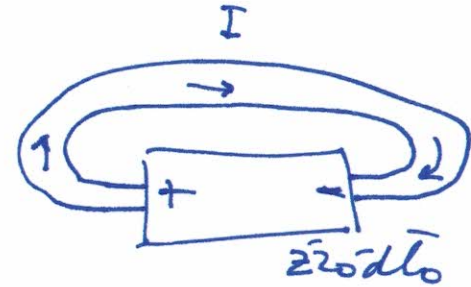
Wtedy prawo Gaussa w dielektryku:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

W ogólnym przypadku ϵ_r może nie być stałą na całej powierzchni Gaussa.

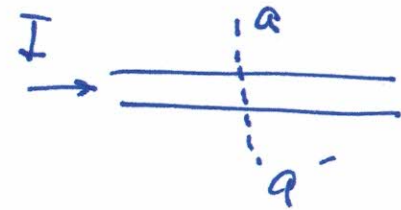
Prąd elektryczny

Dodanie źródła wprowadza różnice potencjałów i wytwarza pole elektryczne w przewodniku, a pole powoduje ruch ładunków



Natężenie prądu elektrycznego

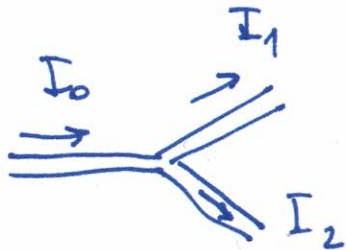
Jeśli ładunek dq przechodzi przez płaszczyznę aa' w czasie dt , to natężenie prądu I przez płaszczyznę jest



$$I = \frac{dq}{dt}$$

Jednostka: $A = \frac{C}{s}$ (amper)

Kulomb/sekunda



Ładunek jest zawsze zachowany.

Dlatego $I_0 = I_1 + I_2$

Strzałka prądu jest w kierunku, w którym poruszałyby się dodatnio naładowane nośniki.

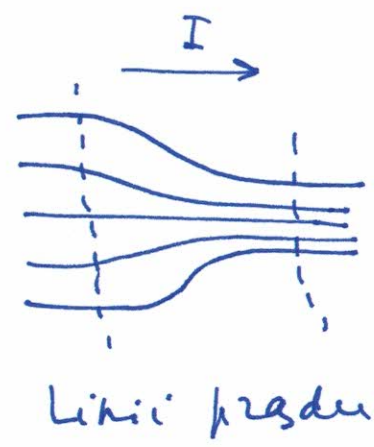
Gęstość prądu elektrycznego

Gęstość prądu jest równa natężeniu prądu, przypadającego na jednostkę pola powierzchni przekroju

$$I = \int \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

jeśli \vec{j} jest prostopadłe do powierzchni i ma jest stały, to

$$I = jS, \quad j = \frac{I}{S}$$



Prędkość unoszenia

Oznaczamy prędkość unoszenia (dryf) elektronów w polu elektrycznym v_d (w kierunku przeciwnym do pola \vec{E})

Liczba nośników w przewodniku o długości L : nSL

Całkowity ładunek w przewodniku o długości L : $q = e(nSL)$

Cały ten ładunek przepływa przez dowolny przekrój za czas $t = \frac{L}{v_d}$

$$\Rightarrow I = \frac{q}{t} = \frac{enSL}{L/v_d} = nSev_d$$

$$v_d \sim 10^{-5} \frac{m}{s}$$
$$v \sim 10^6 \frac{m}{s}$$

$$\Rightarrow v_d = \frac{I}{ens} = \frac{J}{ne}$$

W postaci wektorowej:

$$\boxed{\vec{J} = en\vec{v}_d}$$

en - gęstość ładunku nośników

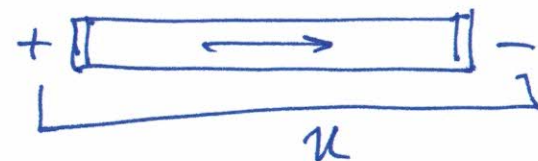
Opór elektryczny

Opór jest określony wzorem:

$$\boxed{R = \frac{U}{I}}$$

definicja oporu

jednostka oporu:



$$\text{ohm} = \Omega = \frac{\text{V}}{\text{A}} \quad \left(\frac{\text{volt}}{\text{amper}} = \text{ohm} \right)$$

Opór elektryczny właściwy:

$$\boxed{\rho = \frac{E}{J}}$$

Przewodność elektryczna właściwa

$$\boxed{\sigma = \frac{1}{\rho}}$$

$$[\rho] = \frac{\text{V/m}}{\text{A/m}^2} = \Omega \cdot \text{m}$$

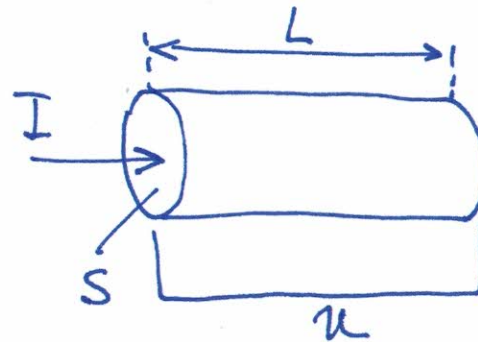
$$\Rightarrow \boxed{\vec{J} = \sigma \vec{E}}$$

$$[\sigma] = \frac{1}{\Omega} = \text{S} \quad (\text{Siemens})$$

Obliczanie oporu elektrycznego

$$R = \frac{U}{I} = \frac{EL}{jS} = \rho \frac{L}{S}$$

$$R = \rho \frac{L}{S}$$



$$U = EL$$

$$I = jS$$

$$\frac{E}{j} = \rho$$

Zależność od temperatury

Wzór empiryczny: $\rho - \rho_0 = \rho_0 \alpha (T - T_0)$

ρ_0 - opór właściwy przy $T = T_0$

ρ ($10^{-8} \Omega \cdot m$)

α - współczynnik temperaturowy oporu właściwego

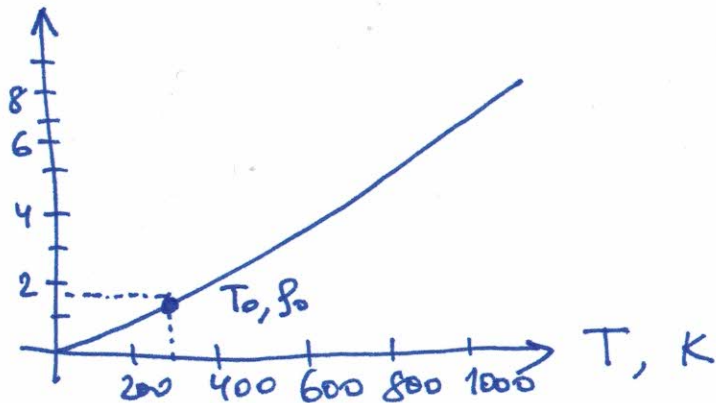


Tabela 27.7. Opór elektryczny właściwy dla niektórych substancji w temperaturze pokojowej (20°C)

Material	Opór elektryczny właściwy ρ [$\Omega \cdot m$]	Współczynnik temperaturowy oporu właściwego α [K^{-1}]
<i>Typowe metale</i>		
Srebro	$1,62 \cdot 10^{-8}$	$4,1 \cdot 10^{-3}$
Miedź	$1,69 \cdot 10^{-8}$	$4,3 \cdot 10^{-3}$
Glin	$2,75 \cdot 10^{-8}$	$4,4 \cdot 10^{-3}$
Wolfram	$5,25 \cdot 10^{-8}$	$4,5 \cdot 10^{-3}$
Żelazo	$9,68 \cdot 10^{-8}$	$6,5 \cdot 10^{-3}$
Platyna	$10,6 \cdot 10^{-8}$	$3,9 \cdot 10^{-3}$
Manganin ^a	$4,82 \cdot 10^{-8}$	$0,002 \cdot 10^{-3}$
<i>Typowe półprzewodniki</i>		
Czysty krzem	$2,5 \cdot 10^3$	$-70 \cdot 10^{-3}$
Krzem typu n ^b	$8,7 \cdot 10^{-4}$	
Krzem typu p ^c	$2,8 \cdot 10^{-3}$	
<i>Typowe izolatory</i>		
Szkło	$10^{10} - 10^{14}$	
Stopiony kwarc	$\sim 10^{16}$	

^a Specjalnie przygotowany stop o małej wartości współczynnika temperaturowego α .

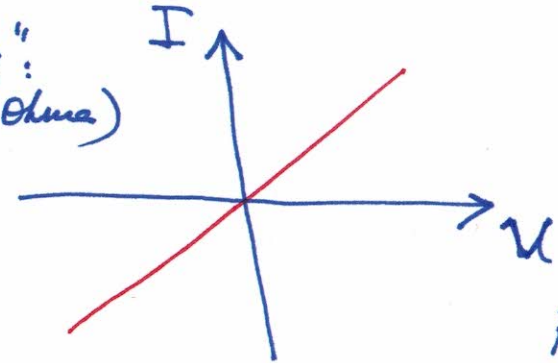
^b Czysty krzem domieszkowany fosforem do otrzymania koncentracji nośników ładunku $10^{23} m^{-3}$.

^c Czysty krzem domieszkowany glinem do otrzymania koncentracji nośników ładunku $10^{23} m^{-3}$.

Prawo Ohma

Natężenie prądu, płynącego przez przewodnik jest zawsze wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów, przyłożonej do przewodnika

Opornik "ohmowy":
(spełnia prawo Ohma)

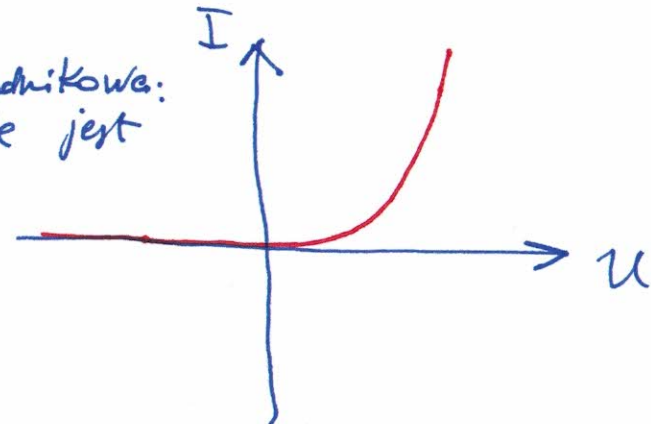


$$R = \frac{U}{I} = \text{const}$$

Element obwodu spełnia prawo Ohma, gdy jego opór nie zależy od wartości i polarizacji przyłożonej różnicy potencjałów.

Materiał przewodzący spełnia prawo Ohma, gdy opór właściwy materiału nie zależy od wartości i kierunku przyłożonego pola elektrycznego

Dioda półprzewodnikowa:
(prawo Ohma nie jest spełnione)



Prawo Ohma - obraz mikroskopowy

14.

Elektron w polu E doznaje przyspieszenia

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m}$$

Czas (średni) między zderzeniami: τ

W czasie τ elektron uzyska prędkość unoszenia $v_d = a\tau$

$$v_d = a\tau = \frac{eE\tau}{m}$$

Gęstość prądu

$$j = env_d = \frac{e^2 n E \tau}{m} = \underbrace{\frac{e^2 n \tau}{m}}_{\sigma} E$$

$$\Rightarrow \boxed{\sigma = \frac{e^2 n \tau}{m}}$$

$$\sigma \approx \text{const}$$